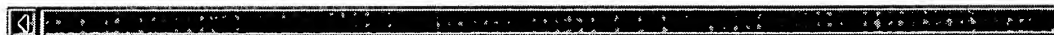
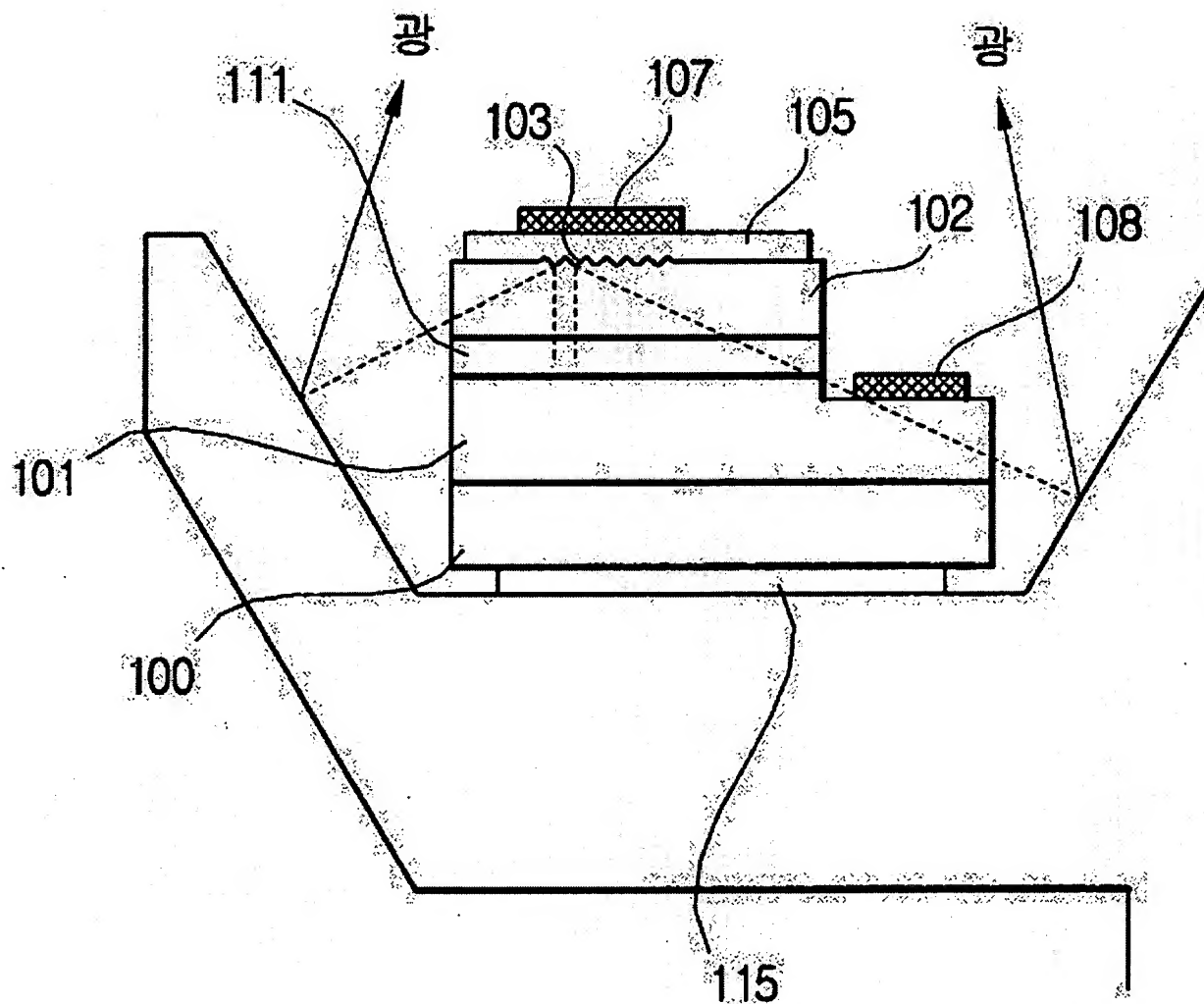


IPC Code	H01L 33/00
Application Number/Date	10-2001-0081876 (2001.12.20)
Unexamined Publication Number/Date	10-2003-0052060 (2003.06.26)
Publication Number/Date	- -
Registration Number/Date	
Right of originl Application	
Origianl Application Number/Date	
Final disposal of an application	거절결정(일반)
International Application Number/Date	
International Unexamined Publication Number/Date	
request for an examination	있음
Date of request for an examination/the number of claims	2001.12.20 / 7
Designated States	
Applicant	엘지전자 주식회사 서울특별시 영등포구 여의도동 **번지 (대한민국)
Inventor/Deviser	장준호 경기도안양시동안구관양동****공작력키APT***.**** (대한민국)
Agent	정중옥 서울시 서초구 서초동 1543-6건설기계회관2층(노벨국제특허법률사무소) (대한민국) 조담 서울 서초구 서초3동 1589-7 현대전원오피스텔12층( 동원국제특허법률사무소) (대한민국)
Priority info (Country/Number/Date)	-
Title of invention	발광 소자 및 그의 제조방법 (light emitting device and method for manufacturing thesame)
Abstract	본 발명은 발광 소자 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 기판의 상부에 형성되어 상부의 일부가 식각된 N-화합물 반도체층과; 상기 N-화합물 반도체층의 식각되지 않은 상부에 형성된 P-화합물 반도체층과; 상기 P-화합물 반도체층의 상부에 형성된 전류 확산용 투명전극과; 상기 전류 확산용 투명전극의 상부에 형성된 P-전극과; 상기 N-화합물 반도체층의 식각된 상부에 형성된 N-전극으로 구성하되,  상기 P-전극과 대향되는 P-화합물 반도체층의 상부 표면에는 P, N 화합물 반도체층의 계면에서 발생하는 광을 반사하여 외부로 방출하기 위한 굴곡이 형성되어 있도록 구성함으로써, P-전극의 하부에 광을 반사시킬 수 있는 굴곡을 형성하여 광 출력 효율을 증가시키고, N-전극의 하부에 접촉저항을 낮출 수 있는 굴곡을 형성하여 소자의 동작전압을 낮출 수 있는 효과가 발생한다.
Representative Claim	기판의 상부에 형성되어 상부의 일부가 식각된 N-화합물 반도체층과; 상기 N-화합물 반도체층의 식각되지 않은 상부에 형성된 P-화합물 반도체층과; 상기 P-화합물 반도체층의 상부에 형성된 전류 확산용 투명전극과; 상기 전류 확산용 투명전극의 상부에 형성된 P-전극과; 상기 N-화합물 반도체층의 식각된 상부에 형성된 N-전극으로 구성하되, 상기 P-전극과 대향되는 P-화합물 반도체층의 상부 표면에는 P, N 화합물 반도체층의 계면에서 발생하는 광을 반사하여 외부로 방출하기 위한 굴곡이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 발광 소자.

Representative  
Drawing



Full-Doc. of  
Unexamined View Full-Doc. of Unexamined Publication  
Publication

Full-Doc. of  
Publication

Facsimile Full-  
Doc.

Full-Doc. of  
correction

Registration Info -

## Trial Info -

<b>Legal Status</b>	112001033871535	(20011220)	특허출원서
	112002513898819	(20020603)	출원인변경신고서
	112002522029354	(20020905)	대리인선임신고서
	952003037720491	(20030929)	의견제출통지서
	412003005552232	(20031016)	출원인정보변경(경정)신고서
	952003051762886	(20031229)	거절결정서